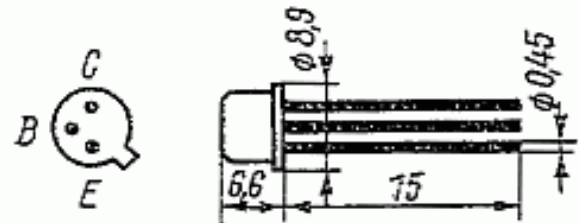


SF 150

Silizium-npn-Planar-Transistor für den Einsatz
in Video-Endstufen, Kollektor am Gehäuse



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,22 \text{ K/mW}$
 $R_{thjc} \leq 0,04 \text{ K/mW}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

$U_{CBO} = 160 \text{ V}$
 $U_{CER} = 160 \text{ V}$ (bei $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$)
 $U_{EBO} = 5 \text{ V}$
 $I_C = 50 \text{ mA}$
 $I_B = 10 \text{ mA}$
 $P_{tot} = 680 \text{ mW}$ (bei $\vartheta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)
 $\vartheta_j = +175 \text{ }^\circ\text{C}$
 $\vartheta_a = -40 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+125 \text{ }^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25 \text{ }^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 140 \text{ V}$)	$\leq 100 \text{ nA}$
U_{CEsat}	(bei $I_C = 30 \text{ mA}$, $I_B = 6 \text{ mA}$)	$\leq 5 \text{ V}$
$U_{(BR) CER}$	(bei $I_C = 5 \text{ mA}$, $R_E = 100 \text{ Ohm}$, $R_{BE} = 5 \text{ kOhm}$)	$\geq 140 \text{ V}$
$U_{(BR) CER}$	(bei $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$, $I_C = 100 \mu\text{A}$)	$\geq 160 \text{ V}$
$U_{(BR) EBO}$	(bei $I_E = 100 \mu\text{A}$)	$\geq 5 \text{ V}$
h_{21E} (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 5 \text{ mA}$)	Gruppe B	28... 71
	C	56... 140
f_r (bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ MHz}$)		$\geq 80 \text{ MHz}$